

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】平成16年11月11日(2004.11.11)

【公開番号】特開2000-133809(P2000-133809A)
【公開日】平成12年5月12日(2000.5.12)
【出願番号】特願平10-305884
【国際特許分類第7版】
H O 1 L 29/786
H O 1 L 21/336
【F I】
H O 1 L 29/78 6 2 7 Z
H O 1 L 29/78 6 2 7 D

【手続補正書】
【提出日】平成15年11月12日(2003.11.12)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】剥離方法、及び薄膜デバイスの転写方法
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】

基板上に分離層を介して存在する被転写層を前記基板から剥離する剥離方法であって、前記分離層に光を照射して、前記被転写層を前記基板から離脱させる工程を具備し、前記光の照射が2回以上行われることを特徴とする剥離方法。

【請求項2】
前記分離層の剥離は、該分離層の界面に粗さを生ぜしめ、前記被転写層と前記分離層の接触面積が減少することによる密着力の低下を利用する請求項1に記載の剥離方法。

【請求項3】
前記分離層は、非晶質シリコンで構成される光吸収層を有する請求項1又は2に記載の剥離方法。

【請求項4】
前記非晶質シリコンは、前記照射光の照射によりポリシリコンに相転移することを特徴とする請求項3に記載の剥離方法。

【請求項5】
前記非晶質シリコンは、水素を2at%以上含有するものである請求項4又は5に記載の剥離方法。

【請求項6】
基板上に形成されており薄膜デバイスを含む被転写層を転写体に転写する薄膜デバイスの転写方法において、
基板上に分離層を形成する工程、
前記分離層上に前記被転写層を形成する工程、
前記被転写層上に接着層を形成する工程、

前記接着層を介して転写体を接着する工程、及び、
前記分離層に光を照射して、前記被転写層を前記基板から離脱させる工程を具備し、前記
光の照射が2回以上行われることを特徴とする薄膜デバイスの転写方法。